

H10 半導体装置；他に分類されない電氣的
固体装置 [2023.01]

H10B 電子記憶装置 [2023.01]

サブクラス内の索引

揮発性記憶装置

| | |
|---------------------|-------|
| SRAM..... | 10/00 |
| DRAM..... | 12/00 |
| 不揮発性記憶装置 | |
| ROM;PROM;EPROM..... | 20/00 |

| | |
|-------------------------------|-------|
| フロ - ティングゲ - トを含む EEPROM..... | 41/00 |
| 電荷トラッピングゲ - ト絶縁体を含む EEPROM | 43/00 |
| 強誘電性のメモリトランジスタを含む FeRAM.. | 51/00 |
| 強誘電性のメモリキャパシタを含む FeRAM..... | 53/00 |
| MRAM..... | 61/00 |
| 抵抗変化メモリ..... | 63/00 |
| 他の EPROM..... | 69/00 |
| 複数の装置の組立体..... | 80/00 |
| 他の電子記憶装置 | |
| このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項 | |
| 99/00 | |

揮発性記憶装置 [2023.01]

| | |
|-----------|---|
| 10/00 | スタティックランダムアクセスメモリ [SRAM] 装置 [2023.01] |
| 10/00 371 | ・パイボ - ラ ,MOS 以外のスタティックランダムアクセスメモリ構造 |
| 10/00 401 | ・接合型または SIT トランジスタメモリ |
| 10/10 | ・パイボ - ラ構成部品からなる SRAM 装置 [2023.01] |
| 12/00 | ダイナミックランダムアクセスメモリ [DRAM] 装置 [2023.01] |
| 12/00 601 | ・1MOS トランジスタ 1 キャパシタ型 DRAM |
| 12/00 611 | ・キャパシタ構造に特徴のあるもの |
| 12/00 615 | ・プレ - ナ型キャパシタ |
| 12/00 621 | ・スタック型キャパシタ |
| A | 横方向にフィンを形成しているもの |
| B | 縦方向の面を利用するもの |
| C | ・ストレ - ジ電極にくぼみ面を有するもの、例 . クラウン型または CUP 型キャパシタ |
| Z | その他のスタック型キャパシタ、例 . 単純スタック型またはスタック型の各種変形 |
| 12/00 625 | ・トレンチ型キャパシタ |
| A | 基板をセルプレ - トとして用いるもの |
| B | 基板をストレ - ジノ - ドとして用いるもの |
| C | トレンチ内にセルプレ - トとストレ - ジノ - ドを各々独立に設けるもの |
| Z | その他のトレンチ型キャパシタ |
| 12/00 631 | ・空乏層容量を利用したキャパシタ |
| 12/00 651 | ・キャパシタ絶縁膜に特徴のあるもの、例 . 絶縁膜材料に特徴のあるもの |
| 12/00 661 | ・その他のキャパシタ |
| 12/00 671 | ・トランジスタ構造に特徴のあるもの |
| A | 縦型トランジスタ |
| B | ・溝型トランジスタ |
| C | SOI 上にトランジスタを形成したものの |
| Z | その他のトランジスタ |
| 12/00 681 | ・その他、例 . レイアウト、に特徴のあるもの |

| | |
|---|---------------------------------|
| A | ワ - ド線のレイアウト、構造または材料に特徴のあるもの |
| B | ビット線のレイアウト、構造または材料に特徴のあるもの |
| C | 接地線または電源線のレイアウト、構造または材料に特徴のあるもの |
| D | 素子分離構造に特徴のあるもの |
| E | チップ全体またはそれに近いレイアウトプランに特徴のあるもの |
| F | 周辺回路部の構造またはレイアウトに特徴のあるもの |
| G | ・センスアンプに特徴のあるもの |
| Z | その他 |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 12/00 691 | ・誤動作防止に特徴のあるもの |
| 12/00 801 | ・1MOS トランジスタ 1 キャパシタ型以外の DRAM |
| 12/00 821 | ・MOS 他のトランジスタからなる DRAM |
| 12/00 841 | ・パイボ - ラ ,MOS 以外のダイナミックランダムアクセスメモリ構造 |
| 12/00 861 | ・接合型または SIT トランジスタメモリ |

| | |
|-------|------------------------------------|
| 12/10 | ・パイボ - ラ構成部品からなる DRAM 装置 [2023.01] |
|-------|------------------------------------|

不揮発性記憶装置 [2023.01]

| | |
|-----------|--|
| 20/00 | 読み出し専用メモリ [ROM] 装置 [2023.01] |
| 20/00 421 | ・パイボ - ラ ,MOS 以外の不揮発性メモリ |
| 20/00 437 | ・接合型または SIT トランジスタメモリ |
| 20/10 | ・パイボ - ラ構成部品からなる ROM 装置 [2023.01] |
| 20/20 | ・電界効果構成部品からなる書き込み可能な ROM[PROM] 装置 (H10B20/10 が優先) [2023.01] |
| 20/25 | ・一回のみ書き込み可能な ROM[OTPROM] 装置、例 . 電氣的に溶断可能なリンクを用いるもの [2023.01] |
| 41/00 | フロ - ティングゲ - トを含む電氣的消去・書き込み可能な ROM[EEPROM] 装置 [2023.01] |
| 41/10 | ・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2023.01] |
| 41/20 | ・三次元配置、例 . 異なる高さに配置されたセル、に特徴のあるもの [2023.01] |
| 41/23 | ・異なる高さのソ - スとドレインを有するもの、例 . 傾斜チャネルを有するもの [2023.01] |
| 41/27 | ・垂直部分を含むチャネル、例 . U 字型チャネル [2023.01] |
| 41/30 | ・メモリコア領域に特徴のあるもの [2023.01] |
| 41/35 | ・セル選択トランジスタを有するもの、例 . NAND[2023.01] |
| 41/40 | ・周辺回路領域に特徴のあるもの [2023.01] |
| 41/41 | ・メモリ領域にセル選択トランジスタを有するもの、例 . NAND[2023.01] |
| 41/42 | ・周辺セルおよびメモリセルの同時製造 [2023.01] |
| 41/43 | ・周辺トランジスタを一種類のみ含むもの [2023.01] |
| 41/44 | ・コントロ - ルゲ - ト層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2023.01] |

| | | | |
|-------|--|-----------|--|
| 41/46 | ・・・ゲ - ト間誘電体層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2023.01] | 69/00 | ゲル - プ H10B41/00-H10B63/00 に包含されない、消去可能でプログラム可能な ROM[EPROM] 装置、例、紫外線による消去可能でプログラム可能な ROM[UVEPROM] 装置 [2023.01] |
| 41/47 | ・・・フロ - ティングゲ - ト層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2023.01] | 80/00 | このサブクラスに包含される、少なくとも 1 つの記憶装置を備える、複数の装置の組立体 [2023.01] |
| 41/48 | ・・・トンネル誘電体層を周辺トランジスタの一部としても用いるもの [2023.01] | 99/00 | このサブクラスの他のゲル - プに分類されない主題事項 [2023.01] |
| 41/49 | ・・・異なる種類の周辺トランジスタを含むもの [2023.01] | 99/00 301 | ・マトリクス半導体装置 |
| 41/50 | ・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2023.01] | 99/00 441 | ・不揮発性 RAM |
| 41/60 | ・コントロ - ルゲ - トがド - プ領域であるもの、例、単層ポリメモリセル [2023.01] | 99/00 449 | ・有機メモリ |
| 41/70 | ・フロ - ティングゲ - トが複数の構成部品で共有される電極であるもの [2023.01] | 99/00 451 | ・他の半導体メモリ |
| 43/00 | 電荷トラッピングゲ - ト絶縁体を含む EEPROM 装置 [2023.01] | 99/00 461 | ・半導体チップ内メモリ |
| 43/10 | ・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2023.01] | 99/00 471 | ・回路配置等の構成 |
| 43/20 | ・三次元配置、例、異なる高さに配置されたセル、に特徴のあるもの [2023.01] | 99/00 481 | ・周辺回路 |
| 43/23 | ・・・異なる高さのソ - スとドレインを有するもの、例、傾斜チャネルを有するもの [2023.01] | 99/00 491 | ・誤動作防止 |
| 43/27 | ・・・垂直部分を含むチャネル、例、U 字型チャネル [2023.01] | 99/00 495 | ・メモリモジュ - ル |
| 43/30 | ・メモリコア領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 43/35 | ・・・セル選択トランジスタを有するもの、例、NAND[2023.01] | | |
| 43/40 | ・周辺回路領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 43/50 | ・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 51/00 | 強誘電性のメモリトランジスタを含む強誘電体メモリ [FeRAM] 装置 [2023.01] | | |
| 51/10 | ・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 51/20 | ・三次元配置、例、異なる高さに配置されたセル、に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 51/30 | ・メモリコア領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 51/40 | ・周辺回路領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 51/50 | ・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 53/00 | 強誘電性のメモリキャパシタを含む強誘電体メモリ [FeRAM] 装置 [2023.01] | | |
| 53/10 | ・上から見たレイアウトに特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 53/20 | ・三次元配置、例、異なる高さに配置されたセル、に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 53/30 | ・メモリコア領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 53/40 | ・周辺回路領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 53/50 | ・コアと周辺回路領域との間の境界領域に特徴のあるもの [2023.01] | | |
| 61/00 | 磁気メモリ装置、例、磁気抵抗 RAM[MRAM] 装置 [2023.01] | | |
| 63/00 | 抵抗変化メモリ装置、例、抵抗 RAM[ReRAM] 装置 [2023.01] | | |
| 63/10 | ・相変化 RAM[PCRAM,PRAM] 装置 [2023.01] | | |